

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIJ470DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 58.8A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SIJ470DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIJ470DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 58.8A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.1 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 56.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIJ470DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 58.8A (Tc) 5W (Ta), 56.8W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	58.8A (Tc)

SIJ470DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIJ470DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIJ470DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIJ470DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIJ461DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p>SIJ458DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ470DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 58.8A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ462DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 46.5A PPAK SO-8</p>
 <p>SIJ478DP-T1-E3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SIJ462DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 46.5A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ478DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ482DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIJ470DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIJ470DP-T1-GE3 Datenblatt	SIJ470DP-T1-GE3-Datenblätter	SIJ470DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIJ470DP-T1-GE3
SIJ470DP-T1-GE3 Vishay	SIJ470DP-T1-GE3-Komponenten	SIJ470DP-T1-GE3-Bild	SIJ470DP-T1-GE3-Teil
SIJ470DP-T1-GE3 Electronic	SIJ470DP-T1-GE3-Verteiler	SIJ470DP-T1-GE3-Aktie	SIJ470DP-T1-GE3 Inventar
SIJ470DP-T1-GE3 Preis	SIJ470DP-T1-GE3 Hersteller	SIJ470DP-T1-GE3 Bild	SIJ470DP-T1-GE3 Online bestellen
SIJ470DP-T1-GE3 Neu	SIJ470DP-T1-GE3 Original	SIJ470DP-T1-GE3 garantiert	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited